# 마이크로컨트롤러 기초(#514112)

#3. 컴퓨터 구조 기초

한림대학교 전자공학과 이선우



### 주요 학습 내용

### 컴퓨터 시스템 구조 기초

- ▶ 디지털 논리 회로 관련 용어, 장치 기초
- 컴퓨터 시스템 구조 관련 기초 내용

#### ▶ 참고문헌

- ▶ "논리회로 이론,실습, 시뮬레이션", 임석구, 홍경호, 한빛미디어, 2007
- ▶ "알기 쉽게 해설한 컴퓨터 구조 완성", 조경산 저, 이한 출판사

### Typical digital signal

- TTL (transistor-transistor logic) logic-level range
  - ▶ Logic "1", "High": voltage +2 ~+5V
  - Logic "0", "Low": voltage  $0 \sim 0.8V$
- ▶ Positive logic(정논리)
  - ▶ HIGH=1 (+5V)
  - ▶ LOW=0 (0V)
- ▶ Negative logic(부논리)
  - ▶ HIGH=0 (+5V)
  - ▶ LOW=1 (0V)

### Logic Gates & Bitwise operator in C language

- $\blacktriangleright$  AND: x=AB or A $\bullet$ B (&)
  - & operator in C language.
  - Ex. a = a & 0x0f (before a=0x35, after a=0x05)
- $\rightarrow$  OR: x=A+B(|)
  - Ex.  $a = a \mid 0xf0$  (before a = 0x05, after a = 0xf5)
- ➤ XOR: x=A⊕B (^)
  - Ex.  $a = a^0$  0xff (before a = 0xa5, after a = 0x5a)
- NOT:  $x=A'(\sim)$ 
  - Ex.  $a = \sim a$  (before a=0x0f, after a=0xf0)



## 조합 논리 (Combinatorial logic)

### ▶ Combinatorial logic이란?

- 조합논리(combinational logic): 게이트의 조합으로 이루어진 회로로 출력이 입력으로 궤환되지 않는 회로
- ▶ 인/디코더, 가/감산기, 승산기
- Y = F(X), where X/Y=입/출력변수의 집합
- ▶ 순서논리(sequential logic): 메모리를 포함

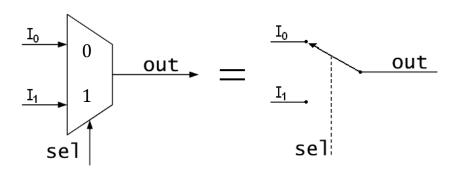
### ▶ 조합논리 설계 단계

- 1. 문제의 기술
- 2. 진리표 작성(문제의 기술에 근거)
- 3. 출력식의 간략화(카노맵, McClusky)
- 4. 논리식의 재전개 bubble, NAND, NOR
- 5. 최종 논리도 작성
- 6. 설계의 문서화 변수와 작동레벨 표시



### Digital Multiplex (Mux)

- 여러 개의 아나로그 혹은 디지털 입력 신호들 중 하나를 선택하는 기능을 하는 장치
- ▶ 2-to-1 Mux
  - If sel=0, then out= $I_0$
  - If sel=1, then out= $I_1$

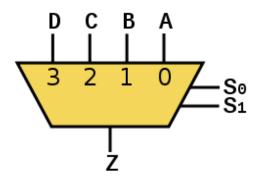


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Multiplexer2.png

▶ 4-to-1 Mux

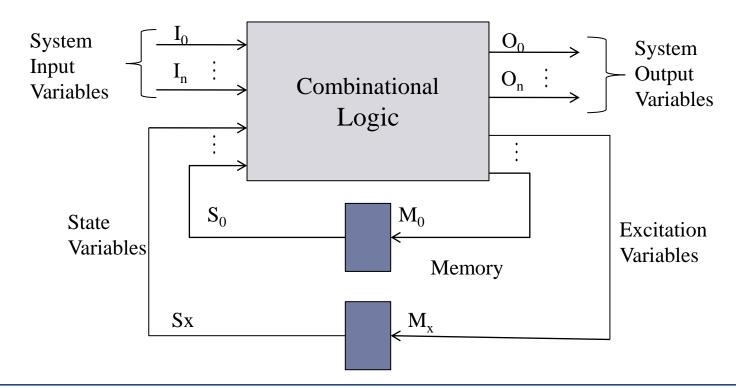
 $\rightarrow$  S1:S0= 00  $\rightarrow$  A

► S1:S0=01→B



### 순서회로 (Sequential Logic)

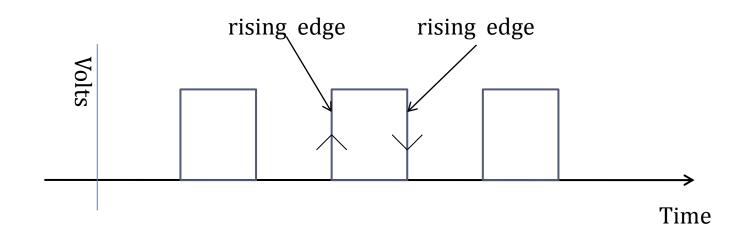
- ▶ 조합논리 + 저장장치(메모리)
- ▶ 입력변수(I) -> 출력변수(O)
- ▶ 내부변수 : 상태변수(S) + 여기변수(E)





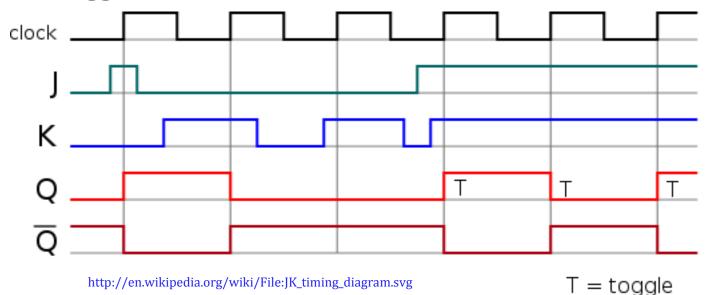
### Clock signals

- 마부분의 디지털 시스템은 "동기 순차 시스템 (synchronous sequential systems)"임
   ⇒ 시스템이 주 클럭 신호(master clock signal)에 따라 동작함을 의미.
- ▶ 대개 다음과 같이 구형파(square wave; 50% duty cycle)



# 타이밍 다이어그램 (Timing diagram)

- ▶ 타이밍 다이어그램: 입력과 출력의 변화와 서로 간의 관계를 시간의 흐름 순으로 가로로 배치해서 나타낸 그래프.
- Ex. JK flip-flop
  - ► J=1, K=0  $\rightarrow$  Set Q=1, /Q=0
  - ▶ J=0, K=1  $\rightarrow$  Reset Q=0
  - ▶  $J=1, K-1 \rightarrow Toggle$

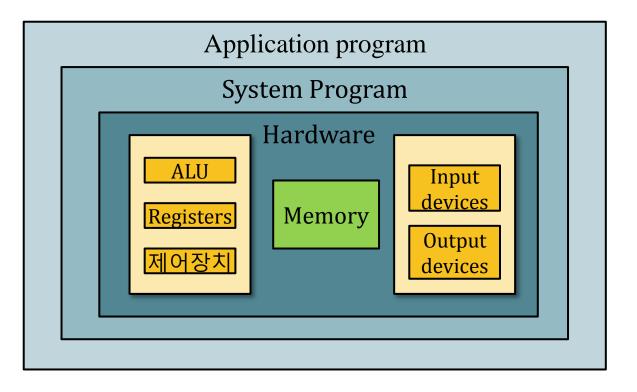




### 컴퓨터 시스템 구성

컴퓨터 시스템 : 컴퓨터의 하드웨어 및 관련 소프트웨어 까지 포함한 용어

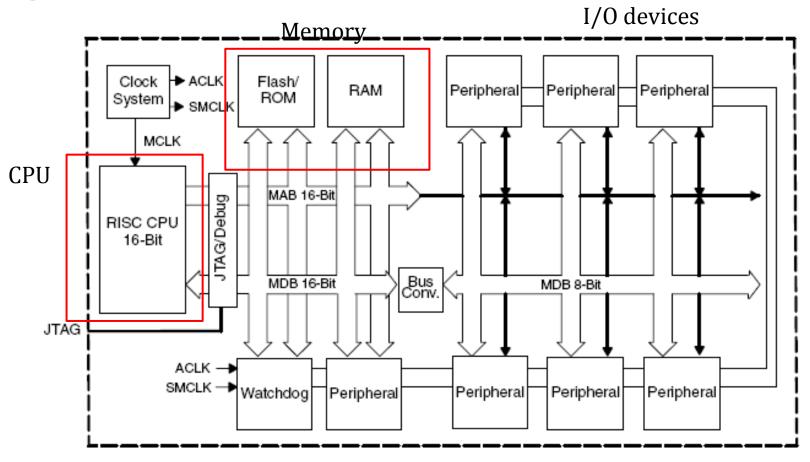
Computer System





### MSP430 Architecture

Figure 1–1. MSP430 Architecture



[1] 1-3 page



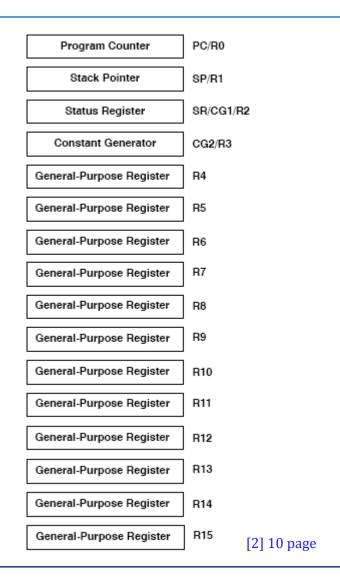
### Central Processing Unit (CPU)

#### CPU

- Computer의 기능을 수행하는 핵심 요소로 프로그램의 명령어를 수행하는 장치
- CPU는 컴퓨터의 여러 기능을 수행하기 위해 일정한 순서로 짜여진 명령어 집합(이를 컴퓨터 프로그램이라 함)을 수행함.
- ▶ CPU의 기본적인 동작은 물리적 메모리(program memory)에 기록되어 있는 machine code(명령어; Instruction)를 읽어와서 (fetch) 해석하고(decode) 실행(execute)하는 동작을 반복한다. (오직 이것만 한다!!)
- ▶ CPU내부 주요 구성
  - ▶ ALU, 레지스터, 제어회로, 내부 연결 장치(버스)

### Registers

- ▶ 프로세서 레지스터(범용 레지 스터)는 작은 양의 정보를 저장 하는 장치 (8bit, 16bit, 32bitregister로 표현하며 이 값은 저 장하는 데이터의 크기를 나타냄)
- ▶ CPU 내부에 있고 CPU 동작을 제 어하고 작동된 결과 등도 저장 된다.
- ▶ MSP430 CPU
  - ▶ 16개의 범용 레지스터 가짐: R0~R15
  - Size: 16bit





### Memory

- ▶ CPU가 동작하기 위해선 반드시 메모리가 필요함. Why?
- Program memory
  - ▶ Program이란?
    - ▶ Definition: A set of instructions, 즉 명령어들이 일정 순서로 잘 작성된 것이 프로그램
    - ▶ 명령어(Instruction)이란? CPU가 할 수 있는 단위 기능들..
  - ▶ 메모리에 저장되어 있는 프로그램은 순서대로 CPU가 읽어 실행함.
  - ▶ ROM 사용
- Data memory
  - 프로그램이 실행하면서 사용하는 메모리로 명령어 수행 결과 등을 저장하는데 사용
  - ▶ RAM 사용



### 컴퓨터 메모리 종류: RAM

- ▶ Volatile(휘발성) memory
  - ▶ 저장된 정보를 유지하기 위해 전력(전원) 필요한 메모리
  - Static RAM
    - ▶ 1 bit 기억을 위해 여러 개의 반도체 소자가 필요 → 비쌈
    - Cache memory, MCU internal data memory etc.
  - Dynamic RAM
    - ▶ 기억 비트당 한 개 소자를 사용하므로 대용량 저가 구현 가능
    - ▶ 전원이 있어도 일정 시간 내에 refresh를 해주어야 함.
    - ▶ 메모리 외부에 refresh를 위한 별도 회로 필요
    - ▶ PC의 주기억장치
  - Upcoming
    - ► T-RAM (Tyristro RAM): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/T-RAM">http://en.wikipedia.org/wiki/T-RAM</a>
    - Z-RAM (Zero capacitor RAM): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Z-RAM">http://en.wikipedia.org/wiki/Z-RAM</a>
    - ► TTRAM (Twin Transistor RAM): http://en.wikipedia.org/wiki/Twin Transistor RAM



### 컴퓨터 메모리 종류: ROM

- ▶ Non-volatile (비휘발성) memory
  - ROM
    - Mask ROM
      - □ ROM 제조시에 프로그램 코드를 이용하여 내부 회로 고정시켜 제조
      - □ 지우기,쓰기 불가
    - ▶ PROM(Programmable ROM)
      - □ OTP(One Time Programmable)
    - EPROM (Erasable PROM)
      - □ 전기적으로 쓰고 광학식(UV light 사용)으로 지움
    - EEPROM(Electrically EPROM)
      - □ 동작 전압보다 큰 전압 이용 지움.
      - □ Byte 단위로 지움.
      - □ Flash 보다 제조 단가 비쌈



### 컴퓨터 메모리 종류: ROM

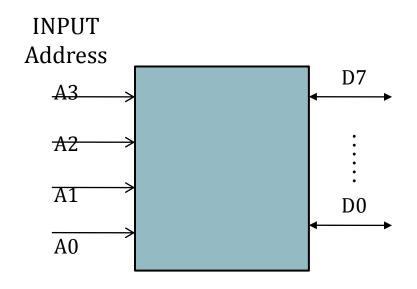
- ▶ Non-volatile (비휘발성) memory
  - ▶ 초기 시대:Paper tape, punched cards
  - Storage devices
    - Magnetic devices: hard discs, floppy discs
    - Optical discs: CDROM, DVD, Blueray
  - ► Flash memory (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flash\_memory">http://en.wikipedia.org/wiki/Flash\_memory</a> )
    - ▶ EEPROM의 한 종류
    - ▶ 제조단가 저렴하여 대용량 가능
    - ▶ Block 단위로 지움.
    - ▶ Write endurance : erase/rewrite 할수 있는 최대 횟수, 10K~1M
    - ▶ 구현 방식에 따라 NOR, NAND flash로 구별



### 메모리 장치 개념

### ▶ 메모리 장치

- ▶ 입력 1: Address
  - 각 데이터를 저장하고 있는 박 스의 번호
  - ▶ 만약 address line이 모두 4bit이 라면, 모두 16개의 박스 존재
- ▶ 입력 2: control line
  - ▶ Chip enable, Output Enable, Write Enable(RAM의 경우) 등 동작 제어를 위한 입력
- ▶ 입/출력: Data
  - ▶ 대개 8bit
  - 저장하기 위한 데이터를 입력하 기위해 혹은 저장된 데이터를 출력하



### 예: 32K bytes SRAM chip

#### CS18LV02565

32K bytes SRAM

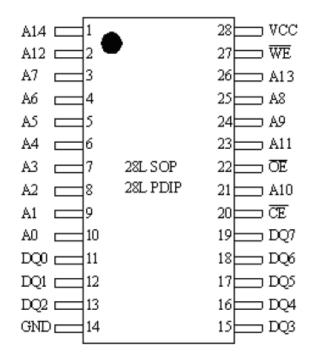
Address inputs: A14~A0 (15bit)

Data: 8bit

Control inputs: /CE, /WE, /OE

#### **■ TRUTH TABLE**

Mode	/CE	/WE	/OE	DQ0~7	Vcc Current
Standby	Н	Х	Х	High Z	I <sub>CCSB</sub> , I <sub>CCSB1</sub>
Output Disabled	L	Н	Н	High Z	I <sub>cc</sub>
Read	L	Н	L	D <sub>OUT</sub>	I <sub>cc</sub>
Write	L	L	Х	D <sub>IN</sub>	I <sub>cc</sub>



Copied from Datasheet

